POWERED BY Dialog



Publication Number: 10-154820 (JP 10154820 A), June 09, 1998

Inventors:

- HASEGAWA TOMOYASU
- NEGORO YASUHIRO
- KAWAI HIROSHI

Applicants

• MURATA MFG CO LTD (A Japanese Company or Corporation), JP (Japan)

Application Number: 08-329215 (JP 96329215), November 25, 1996

International Class (IPC Edition 6):

- H01L-029/84
- G01C-019/56
- G01P-009/04
- G01P-015/125
- H01L-021/304

JAPIO Class:

- 42.2 (ELECTRONICS--- Solid State Components)
- 46.1 (INSTRUMENTATION--- Measurement)

Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for manufacturing a vibrating element through simple steps with an improved yield.

SOLUTION: A movable part 4 is formed on a sacrificial layer 10 on a substrate 1, parts of the sacrificial layer 10 located underside the movable part 4 are removed using an etching solution. And the substrate is washed to remove the etching solution and then dried to remove the washing solution. After the drying step, an electrode member 14 is disposed above the movable part 4. The electrode member 14 has an electrode face 14a opposed to the movable part 4 through a gap. A voltage is applied between the movable part 4 and the electrode face 14a to provide such an electrostatic force as to pull up the movable part 4 toward the electrode face. As a result, the movable part 4 adhered to the substrate 1 in the drying step is peeled off from the substrate 1 and a gap 5 is formed between the substrate 1 and movable part 4, thus completing a vibrating element. By using the above electrostatic force, the gap 5 between the substrate 1 and the movable part 4 can be reliably and simply formed, damage of the movable part 4 can be prevented, and the yield of the vibrating element can be improved.

JAPIO

© 2005 Japan Patent Information Organization. All rights reserved. Dialog® File Number 347 Accession Number 5871720

拒絕引用SONP [76年11 000

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-154820

(43)公開日 平成10年(1998)6月9日

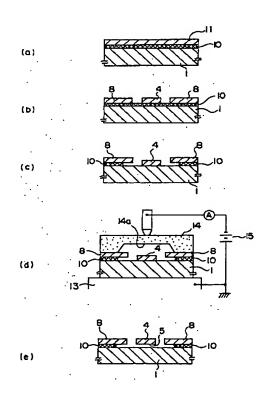
(51) Int. Cl. 6		識別記号		FI				
	29/84	ر، عاد در بود		H01L	29/84		Z.	
G01C	19/56			G 0 1 C	19/56		2	
	9/04			G 0 1 P	- •			
	15/125				15/125			
H01L	21/304	3 4 1		H01L	21/304	3 4 1	Z	
	審査請求	未請求 請求項の数3	FD			(全8	3頁)	
(21)出願番号	特願平8-329215			(71)出願人	人 000006231 株式会社村田製作所			
(22)出願日	平成8年(1996)11月25日						天神二丁目26番10号	
				(72)発明者	長谷川	友保		
					京都府	長岡京市	天神二丁目26番10号	株式
			Ì		会社村	田製作所	内	
				(72)発明者	根来	泰宏		
					京都府	長岡京市	天神二丁目26番10号	株式
					会社村	田製作所	内	
		•		(72)発明者	川合	浩史		
					京都府	長岡京市	天神二丁目26番10号	株式
					会社村	田製作所	内	
				(74)代理人	弁理士	五十嵐	清	
				<u></u>	~*·			

(54) 【発明の名称】振動素子の製造方法

(57)【要約】

【課題】 簡単な工程で製造でき、しかも、歩留まりを 向上させる振動素子の製造方法を提供する。

【解決手段】 基板1上の犠牲層10の上に可動部4を形成し、可動部4の下側の犠牲層10をエッチング液を 用いて除去する。そして、エッチング液を洗浄した後に 洗浄液の乾燥を行う。この乾燥工程後に、可動部4の上側に電極体14を配設する。この電極体14には可動部4 に空隙を介して対向する電極面14 a を有する。上記可動部4と電極面14 a 間に電圧を印加して可動部4を電極面側に引き上げる静電力を作用させ、前記乾燥工程で基板1に付着した可動部4を基板1から剥がし、基板1と可動部4間に空隙5を形成して振動素子が完成する。上記静電力を用いることにより、基板1と可動部4間に空隙5を確実かつ簡単に形成できる上に、可動部4の破損が防止できて振動素子の歩留まりが向上する。



20

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板に固定形成される固定部と、該固定 部に支持され基板面と空隙を介して対向配設される可動 部とを有した振動素子の製造方法において、まず、基板 面の可動部形成領域に形成された犠牲層の上側に前記固 定部に連接される可動部を形成し、その後、エッチング 液を用いて上記可動部の下側の犠牲層を除去し、然る 後、エッチング液を洗浄し、その後の乾燥工程で上記洗 浄液を乾燥除去し、次に、上記可動部の上側に空隙を介 して対向する対向電極を配置し、上記可動部と対向電極 間に電圧を印加し、可動部を対向電極側に引き上げる静 電力を作用させ、前記乾燥工程時の洗浄液の表面張力に より基板に付着した可動部を基板から剥がし、基板と可 動部間に空隙を形成する振動素子の製造方法。

【請求項2】 半導体基板に固定形成される固定部と、 該固定部に支持され基板面と空隙を介して対向配設され る可動部とを有した振動素子の製造方法において、ま ず、基板面の可動部形成領域に形成された犠牲層の上側 に前記固定部に連接される可動部を形成し、その後、エ ッチング液を用いて上記可動部の下側の犠牲層を除去 し、然る後、エッチング液を洗浄し、その後の乾燥工程 で上記洗浄液を乾燥除去し、次に、半導体基板の上側に ガラス材料で形成された蓋部を配置して上記可動部の上 側を空隙を介して上記蓋部により覆い、半導体基板と蓋 部に電圧を印加して半導体基板と蓋部を陽極接合手法に より接合させると共に、この蓋部への電圧印加によりガ ラス材料の蓋部を電極として機能させて可動部と蓋部間 に電圧を印加し、可動部を蓋部側に引き上げる静電力を 作用させて前記乾燥工程時の洗浄液の表面張力により半 導体基板に付着した可動部を半導体基板から剥がし、半 30 導体基板と可動部の間に空隙を形成する振動素子の製造 方法。

【請求項3】 可動部の上側に空隙を介して配設される 電極の面に可動部が接着するのを防止するための接着防 止膜が形成されていることを特徴とする請求項1又は請 求項2記載の振動素子の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明が属する技術分野】本発明は、加速度センサやマ イクロジャイロ等の振動素子を製造する方法に関するも 40 向配設する可動部4が完成する。 のである。

[0002]

【従来の技術】図3の(a)には半導体マイクロマシニ ング技術等により製造される振動素子の一例が示され、 図3の(b)には図3の(a)に示すA-A断面図が示 されている。この振動素子は、基板1と、固定部である アンカー2(2a, 2b, 2c, 2d)と、梁部3と、 可動部4とを有して構成されており、図3の(a)や (b) に示すように、基板1にアンカー2 (2 a, 2

部3の一端側がそれぞれ連接されており、各梁部3の他 端側には共通の可動部4が連接されている。

【0003】上記梁部3と可動部4は、基板1と空隙5 を介して対向配設されており、図3の(b)に示す高さ 方向に変位が可能な構成になっている。また、図3の (a) に示す梁部3はコ字形状に折曲形成されているの で、可動部4は図3の(a)に示す横方向や縦方向に変 位可能な構成になっている。

【0004】上記可動部4には櫛歯形状の可動電極6が 突設され、この可動電極6に噛み合うように、櫛歯形状 の固定電極7が基板1に固定された支持部8から伸張形 成されており、上記可動電極6と固定電極7の電極面は 互いに対向している。

【0005】上記構成の振動素子では、例えば、可動部 4が図3の(a)に示す縦方向に変位すると、可動電極 6と固定電極7の間の間隔が可変し、可動電極6と固定 電極7間の静電容量が可変する。このことから、可動電 極6と固定電極7間の静電容量の可変量を上記可動部4 の縦方向の変位量として検出することが可能である。

【0006】例えば、上記振動素子が加速度センサとし て使用される場合には、上記可動部 4 の変位量が加速度 の大きさに対応し、上記可動部4の変位量に基づき加速 度の大きさを検出することができる。また、上記振動素 子がさらに、可動部4を振動させる振動発生手段を備 え、マイクロジャイロとして使用されるときには、上記 可動部4の変位量は角速度の大きさに対応しており、上 記可動部4の変位量に基づき角速度の大きさを求めるこ とができる。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】ところで、上記構成の 振動素子の可動部4は次のようにして製造される。ま ず、図4の(a)に示すように、基板1上の可動部4の 形成領域に形成された犠牲層10の上に、アンカー2に 梁部3を介して連接する可動部4を形成する。その後、 可動部4の下側の犠牲層10をエッチング液(エッチャ ント)を用いて除去する。

【0008】そして、上記エッチング液を洗浄する洗浄 工程とその洗浄液を乾燥させる乾燥工程が順に行われ、 図4の(b)に示すように、基板1に空隙5を介して対

【0009】しかしながら、上記エッチング液の洗浄工 程で、基板1と可動部4間の数μmという狭い隙間に入 り込んだ洗浄液の表面張力により、可動部4は洗浄液の 表面に付着し、この状態で、次の乾燥工程で洗浄液が蒸 発乾燥されることになるので、洗浄液の蒸発に伴って可 動部4が基板1側に変位し、洗浄液が完全に乾燥したと きには、図5に示すように可動部4が基板1に付着固定 されてしまう。

【0010】このように、可動部4が基板1に固定され b, 2c, 2d) が固定形成され、各アンカー2には梁 50 た状態では、可動部4が変位できないので、振動素子と

20

して機能できないという問題がある。

【0011】そこで、上記問題を解決するために、例えば、凍結乾燥手法が提案されている。凍結乾燥手法とは、エッチング液を洗浄した後に、その洗浄液を2ーメチルー2ープロパノール等の凍結専用の液に置換し、その凍結専用の液を凍結させ、その凍結した液を真空中で昇華させるというものである。

【0012】しかしながら、上記凍結乾燥手法では、凍結専用の特殊な液が必要である上に、エッチング液を洗浄した後に洗浄液を上記特殊な液に置換させ、その凍結専用の液を凍結させて昇華させるというように、工程が煩雑になる。

【0013】また、基板1と可動部4間の凍結専用液が多過ぎると、その液を凍結したときに、液の凍結作用に起因して可動部4を破損させてしまうという問題が生じる。上記と反対に、基板1と可動部4間の凍結専用の液が少な過ぎると、凍結専用液の表面張力により可動部4が基板1に付着した状態で上記凍結専用液の凍結・昇華が行われ、可動部4は基板1に付着固定されてしまう。

【0014】上記可動部4の破損の問題や、可動部4が基板1に付着するという問題を解決するためには、基板1と可動部4間に入り込ませる凍結専用液の液量の制御が必要であるが、液量の制御は非常に困難であり、上記のように、可動部4が破壊されてしまったり、可動部4が基板1に付着固定されることが多発して振動素子の歩留まりを低下させ、振動素子の価格を高価にするという問題がある。

【0015】また、二酸化炭素の超臨界状態を利用した 洗浄液の乾燥手法も知られているが、この乾燥手法は作 業工程が煩雑になると共に、二酸化炭素の超臨界状態を 作り出すための専用の装置を導入しなければならず、そ の装置は高価なものであるので、振動素子の価格を高価 にしてしまうという問題がある。

【0016】この発明は上記課題を解決するためになされたものであり、その目的は、簡単な工程で製造することができ、かつ、振動素子の製造の歩留まりを向上させて安価な振動素子を提供することが可能な振動素子の製造方法を提供することにある。

[0017]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため 40 にこの発明は次のような構成をもって前記課題を解決する手段としている。すなわち、第1の発明は、基板に固定形成される固定部と、該固定部に支持され基板面と空隙を介して対向配設される可動部とを有した振動素子の製造方法において、まず、基板面の可動部形成領域に形成された犠牲層の上側に前記固定部に連接される可動部を形成し、その後、エッチング液を用いて上記可動部の下側の犠牲層を除去し、然る後、エッチング液を洗浄し、その後の乾燥工程で上記洗浄液を乾燥除去し、次に、上記可動部の上側に空隙を介して対向する対向電極 50

を配置し、上記可動部と対向電極間に電圧を印加し、可 動部を対向電極側に引き上げる静電力を作用させ、前記 乾燥工程時の洗浄液の表面張力により基板に付着した可 動部を基板から剥がし、基板と可動部間に空隙を形成す る構成をもって前記課題を解決する手段としている。

【0018】第2の発明は、半導体基板に固定形成され る固定部と、該固定部に支持され基板面と空隙を介して 対向配設される可動部とを有した振動素子の製造方法に おいて、まず、基板面の可動部形成領域に形成された犠 牲層の上側に前記固定部に連接される可動部を形成し、 その後、エッチング液を用いて上記可動部の下側の犠牲 層を除去し、然る後、エッチング液を洗浄し、その後の 乾燥工程で上記洗浄液を乾燥除去し、次に、半導体基板 の上側にガラス材料で形成された蓋部を配置して上記可 動部の上側を空隙を介して上記蓋部により覆い、半導体 基板と蓋部に電圧を印加して半導体基板と蓋部を陽極接 合手法により接合させると共に、この蓋部への電圧印加 によりガラス材料の蓋部を電極として機能させて可動部 と蓋部間に電圧を印加し、可動部を蓋部側に引き上げる 静電力を作用させて前記乾燥工程時の洗浄液の表面張力 により半導体基板に付着した可動部を半導体基板から剥 がし、半導体基板と可動部の間に空隙を形成する構成を もって前記課題を解決する手段としている。

【0019】第3の発明は、上記第1又は第2の発明を 構成する可動部の上側に空隙を介して配設される電極の 面に可動部が接着するのを防止するための接着防止膜が 形成されている構成をもって前記課題を解決する手段と している。

【0020】上記構成の発明において、乾燥工程で洗浄液の表面張力により基板に付着した可動部を静電力により基板から剥がし、基板と可動部間に空隙を形成するようにしたので、乾燥工程で可動部が基板に付着しないように、例えば、凍結乾燥手法を用いる必要がなく、乾燥工程の煩雑化が回避される。

【0021】また、可動部を引き上げる静電力の制御は 可動部と該可動部に対向配設される対向電極との間に印 加する電圧の大きさにより制御され、その電圧制御は容 易であるので、上記静電力の制御を簡単に行うことが可 能であり、確実に可動部を基板から剥がすことができ、 40 かつ、可動部の破損を防止できる。このことから、振動 素子の歩留まりが向上し、振動素子の価格の低下を図る

[0022]

ことが可能である。

【発明の実施の形態】以下に、この発明の実施形態例を 図面に基づき説明する。

【0023】図1には第1の実施形態例の振動素子の製造方法が示されている。この実施形態例に示す振動素子は前記図3に示す振動素子であり、図3の振動素子の構成は前述したので、その重複説明は省略する。なお、図1には図3のA-A断面部分が模式的に示されている。

ô

【0024】この実施形態例において特徴的なことは、 乾燥工程時に洗浄液の表面張力により基板1に付着した 可動部4を、乾燥工程の後に、基板1から静電力を用い て剥がし、基板1と可動部4間に空隙5を形成すること である。以下に、この実施形態例の振動素子の製造方法 の詳細な説明を述べる。

【0025】この実施形態例では、図1の(a)に示す SOI(Silicon on insulator) 基板を用いる。このS OI基板はシリコンで構成された基板1に酸化物で形成 された犠牲層10とシリコンの層11が順に予め積層形 10 成された基板である。

【0026】まず、図3の(a)に示すアンカー2と梁 部3と可動部4と可動電極6と固定電極7と支持部8を形成する領域以外のシリコン層11の部分を、図1の(b)に示すように、RIE(リアクティブイオンエッチング)等によりドライエッチング除去する。そして、図1の(c)に示すように、梁部3と可動部4と可動電

図1の(c)に示すように、梁部3と可動部4と可動電極6と固定電極7の下側の犠牲層10をHF溶液等のエッチング液によりウェットエッチング除去する。このエッチング除去の工程で、梁部3と可動部4と可動電極6と固定電極7は基板1から離間した状態となる。

【0027】次に、純水を用いてエッチング液を洗浄し、その後、メタノールやアセトン等の揮発性の高い溶液に切り替えて引き続き洗浄を行ってエッチング液を完全に除去する。そして、上記洗浄工程の後に、基板1を大気中に配置して洗浄液の乾燥を行う。このとき、基板に付着している洗浄液は、上記の如く、揮発性の高い溶液であることから、洗浄液は基板からより早く蒸発し、基板の乾燥時間の短縮を図ることができる。この乾燥工程時に洗浄液の表面張力により、図1の(c)に示すよ30うに、可動部4が基板1に付着する。

【0028】次に、図1の(d)に示すように、上記基板1を予め定めた作業台13に配置すると共に、基板1の上側に単結晶のシリコンにより形成された電極体14を配設する。この電極体14には可動部4に対向する領域に凹部が形成されており、可動部4の上側を空隙を介して電極体14により覆うことができる。上記電極体14の凹部底面14aが対向電極と14の凹部底面14aが対向電極と成している。また、上記作業台13は導電性の高い材料により形成されており、この作業台13は電圧印加手段15に接続されている。

【0029】そして、上記電極体14および作業台13を介して基板1に上記電圧印加手段15により電圧を印加することにより、可動部4と電極体14の凹部底面14a間にも上記印加電圧に対応した分の電圧が印加され、可動部4を電極体14側に引き上げる静電力を作用させる。

【0030】上記静電力により可動部4は電極体14側に引き上げられて基板1から剥がれ、図1の(e)に示 50

すように、基板1と可動部4間に空隙5が形成されて振動素子が完成する。

【0031】なお、上記静電力の大きさは可動部4を基板1から剥がすことが可能な適宜の大きさが設定され、静電力の大きさの制御は電圧印加手段15から可動部4と凹部底面14a間に印加される電圧の制御により行われる。また、上記静電力により可動部4が電極体14側に引き上げられたときに可動部4が電極体14の凹部底面14aに接触しないように、電極体14の凹部の深さが設定されている。

【0032】この実施形態例によれば、乾燥工程の後に、静電力を用いて可動部4を基板1から剥がして基板1と可動部4間に空隙5を形成するようにしたので、乾燥工程で、基板1に可動部4が付着しないように前記凍結乾燥手法等の特殊な乾燥手法を用いる必要がない。上記凍結乾燥手法等の乾燥手法は、前述したように、工程が煩雑で、面倒であるという問題があるが、この実施形態例では、上記のように、特殊な乾燥手法を用いることなく、基板1を大気中に配設して洗浄液を蒸発乾燥させるだけなので、乾燥工程の簡略化を図ることができる。

【0033】また、凍結乾燥手法のように、基板1と可動部4間の液を凍結させることがないので、液の凍結作用により可動部4が破損するという問題を防止することができる。さらに、上記基板1と可動部4間に作用させる静電力の大きさは基板1と可動部4間の印加電圧の制御は簡単であることから、上記静電力を制御して可動部4を簡単、かつ、確実に基板1から剥がすことができる。上記のように、可動部4が破損するという問題と、可動部4が基板1に付着固定するという問題とが共に回避されるので、振動素子の歩留まりを格段に向上させることができる。

【0034】さらに、上記基板1と可動部4間に電圧を 印加するための作業設備は安価であるので、設備導入の 費用が少なくて済み、上記振動素子の歩留まり向上の効 果と相俟って、振動素子の価格を大幅に安価にすること が可能である。

【0035】以下に、第2の実施形態例を説明する。この実施形態例は、図2の(e)に示すように、可動部4が蓋部16によりパッケージされた振動素子に適用するものである。なお、この実施形態例の説明において、前記第1の実施形態例と同一名称部分には同一符号を付し、その重複説明は省略する。

【0036】まず、前記第1の実施形態例と同様に、図2の(a)に示すようなSOI基板を用意し、図2の(b)に示すように、可動部4等の振動素子の構成部分をRIE等の手法により形成する。その後、図2の(c)に示すように、可動部4等の下側の犠牲層10をエッチング除去し、エッチング液を洗浄して乾燥させ

る。

10

【0037】然る後、図2の(d)に示すように、基板 1を作業台13に配置すると共に、予め作製された蓋部 16を基板1の上に配設する。この蓋部16はナトリウ ムプラスイオン等のプラスイオンを含有するガラス材料 により形成されており、蓋部16には可動部4に対向す る領域に凹部が形成され、可動部4の上を空隙を介して 蓋部16により覆うことが可能である。上記蓋部16に 形成された凹部底面は可動部4と対向し、この凹部底面 には接着防止膜17が形成されている。この接着防止膜 17は、Au, Cr, アルミニウム, Pt等の金属や、 SiN等の窒化物等の付着エネルギーの小さい材料によ り形成されている。

【0038】そして、これらを減圧雰囲気下で接合温度 (300℃以上)まで加熱しつつ、電圧印加手段15か ら蓋部16および作業台13を介して基板1に電圧を印 加することにより、蓋部16とシリコン層11 (支持部 8) の接触面が陽極接合し、可動部4のパッケージが行 われる。

【0039】同時に、蓋部16に含有されているプラス イオンが蓋部16内部を移動し、蓋部16が分極して電 極と成し、蓋部16の凹部底面と可動部4間にも電圧が 印加され、可動部4を蓋部16側に引き上げる静電力が 作用して、前記乾燥工程で洗浄液の表面張力により基板 1に付着した可動部4が基板1から剥がされ、図2の (e) に示すように、基板1と可動部4間に空隙5を形 成し、可動部4がパッケージされた振動素子が完成す

【0040】前記接着防止膜17は、前記の如く、付着 エネルギーの小さい材料で形成されているので、上記の ように、静電力により可動部4を蓋部16側に引き上げ 30 たときに可動部4が接着防止膜17に接触しても、可動 部4と接着防止膜17の接触面に結合反応が発生せず、 静電力の停止後に、可動部4は接着防止膜17から離 れ、可動部4と接着防止膜17間に空隙を形成すること ができる。

【0041】なお、上記電圧印加の工程で、可動部4が 蓋部16の凹部底面に接触しないように、蓋部16の凹 部の深さを設定することにより、可動部4が蓋部16の 凹部底面に接触するのを防止することができるので、こ のような場合には、上記接着防止膜17を設けなくても よい。

【0042】この実施形態例によれば、蓋部16で可動 部4のパッケージを行うときに、蓋部16を可動部4に 対向する電極として機能させて可動部4と蓋部16間に 電圧を印加し、その電圧印加により生じる静電力を利用 して、乾燥工程で基板1に付着した可動部4を基板1か ら剥がすようにしたので、前記第1の実施形態例同様の 効果を奏することが可能である上に、 蓋部 16 による可 動部4のパッケージと、可動部4の引き剥がし作業とを 同時に行うことができるので、可動部4のパッケージの 50 す振動素子を例にして説明したが、この発明は図3の振

工程と、可動部4を基板1から剥がすための工程とを別 々に設ける必要がなく、工程の簡略化を図ることができ る。

【0043】また、蓋部16の凹部底面に接着防止膜1 7を設けたので、静電力により可動部4が接着防止膜1 7に接触しても、接着防止膜17は付着エネルギーが小 さいもので形成されているので、可動部4と接着防止膜 17の接触面が接合することはなく、静電力を停止させ た後に可動部4が接着防止膜17から離れ、このことに より、可動部4が蓋部16に付着固定されてしまうとい う問題を確実に回避することができる。

【0044】なお、この発明は上記各実施形態例に限定 されるものではなく、様々な実施の形態を採り得る。例 えば、上記各実施形態例では、SOI基板を用いていた が、SOI基板を用いずに、基板1に犠牲層10を積層 し、その犠牲層10の上側にシリコン層11を形成する という工程を行った後に、前記各実施形態例同様の工程 を行って振動素子を製造するようにしてもよい。

【0045】また、上記第1の実施形態例に示した電極 20 体14はシリコンにより構成されていたが、シリコン以 外の半導体により形成してもよいし、金属により形成し てもよいし、ナトリウムプラスイオン等のプラスイオン を含有するガラス材料により形成してもよい。このよう に、電圧印加により電極として機能することが可能な材 料であれば、シリコン以外の材料により電極体14を構 成してもよい。

【0046】さらに、第1の実施形態例に示した電極体 14の凹部底面14 aに、第2の実施形態例に示した接 着防止膜17同様の接着防止膜を設けてもよい。さら に、接着防止膜17は複数の異なる材料の層を積層形成 した積層膜により形成してもよい。

【0047】さらに、上記各実施形態例では、基板1は シリコンにより形成されていたが、基板1はシリコン以 外の半導体で形成してもよい。

【0048】さらに、上記各実施形態例では、RIE手 法により可動部4等の振動素子の構成部分を形成してい たが、シリコン層11の上に可動部4等の形成領域を定 めるパターンを形成し、そのパターン以外のシリコン層 11の領域をエッチング液を用いてエッチング除去し、 その後、上記パターンを取り除いて可動部4等を形成す るようにしてもよい。

【0049】さらに、上記各実施形態例では、可動部4 はシリコンにより形成されていたが、シリコン以外の半 導体や、アルミニウムやNiやPt等の金属等、シリコ ン以外の材料により形成してもよい。また、可動部4は 半導体や、アルミニウムやNiやPt等の金属や、絶縁 体等の材料のうち、複数を積層した積層体により形成し てもよい。

【0050】さらに、上記各実施形態例では、図3に示

る。

9

動素子に限定されるものではなく、基板面と空隙を介して対向配設する可動部を有した振動素子に適用することが可能であり、上記各実施形態例同様にして基板面と可動部間に空隙を形成し振動素子を製造することにより、上記各実施形態例同様の優れた効果を得ることが可能である。

[0051]

【発明の効果】この発明によれば、乾燥工程の後に、可動部の上に空隙を介して電極を対向配設して可動部と対向電極間に電圧を印加し、あるいは、基板に蓋部を配置 10 して可動部の上側を空隙を介して蓋部により覆い、蓋部を電極として機能させて蓋部と可動部間に電圧を印加して、可動部を上側に引き上げる静電力を作用させ、乾燥工程で洗浄液の表面張力により基板に付着した可動部を基板から剥がし、可動部と基板の間に空隙を形成するようにしたので、可動部が基板に付着しないように凍結乾燥手法等の面倒な乾燥手法を用いる必要がなく、洗浄液の乾燥を簡単に行うことができ、乾燥工程の簡略化を図ることができる。

【0052】また、上記の如く、凍結乾燥手法を用いる 20 必要がないので、乾燥工程で、基板と可動部間の溶液の 凍結に起因して可動部が破損するという問題を回避する ことができる。さらに、上記可動部を引き上げる静電力の制御は可動部と電極間の印加電圧制御により行うことができ、この印加電圧の制御は簡単に行うことができるので、静電力の大きさを制御して可動部を簡単、かつ、確実に基板から剥がすことができる。このように、可動部の破損の問題と、可動部の基板への付着固定の問題とが共に回避できるので、振動素子の歩留まりを格段に向上させることが可能で、このことにより、振動素子の価 30 格を安価にすることができる。

【0053】さらに、上記可動部に静電力を作用させる ための設備は安価であることから、設備導入費用が少な くて済み、上記振動素子の歩留まり向上の効果と相俟っ て、振動素子の価格をより安価にすることが可能であ 【0054】基板に蓋部を配置して可動部の上側を空隙を介して蓋部により覆い、蓋部を電極として機能させて蓋部と可動部間に電圧を印加し、可動部を上側に引き上げる静電力を作用させ、乾燥工程で洗浄液の表面張力により基板に付着した可動部を基板から剥がし、可動部と基板の間に空隙を形成する発明にあっては、上記静電力を発生させるときの基板と蓋部への通電により、基板と蓋部の接触面が陽極接合して可動部を上記蓋部によりパッケージすることができる。このように、可動部のパッケージの作業と、可動部の引き剥がしの作業とを同時に行うことができるので、製造工程の増加を防止すること

【0055】電極面に接着防止膜を設けた発明にあっては、接着防止膜を付着エネルギーの小さい材料で形成することにより、静電力により可動部が電極面の接着防止膜に接触しても、可動部と接着防止膜の接触面の結合反応を防止することができ、可動部が電極面に接着してしまうという問題を確実に回避することが可能である。

20 【図面の簡単な説明】

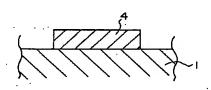
が可能である。

- 【図1】第1の実施形態例を示す説明図である。
- 【図2】第2の実施形態例を示す説明図である。
- 【図3】振動素子の一例を示す説明図である。
- 【図4】従来の振動素子の製造手法を示す説明図である。
- 【図5】従来の課題を示すモデル図である。

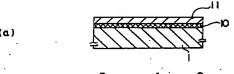
【符号の説明】

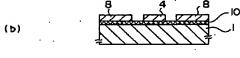
- 1 基板
- 2 アンカー
- 0 4 可動部
 - 5 空隙
 - 10 犠牲層
 - 14 電極体
 - 16 蓋部
 - 17 接着防止膜

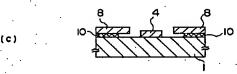
【図5】

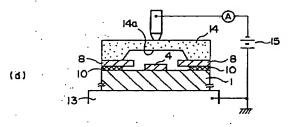


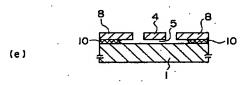
【図1】



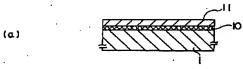


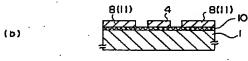


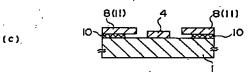


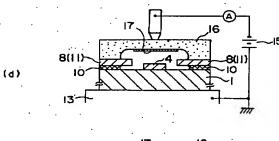


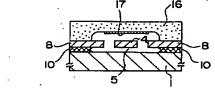
【図2】





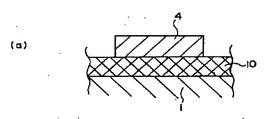


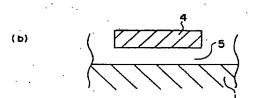




(e)

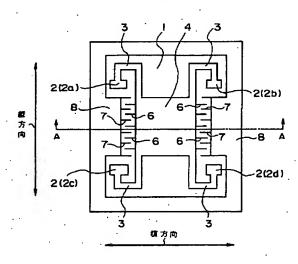
【図4】



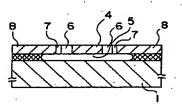


【図3】

(a)



. (P)



高さ方向